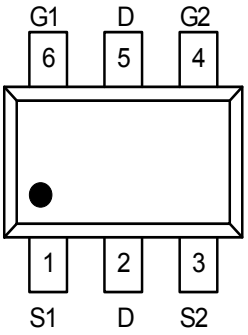
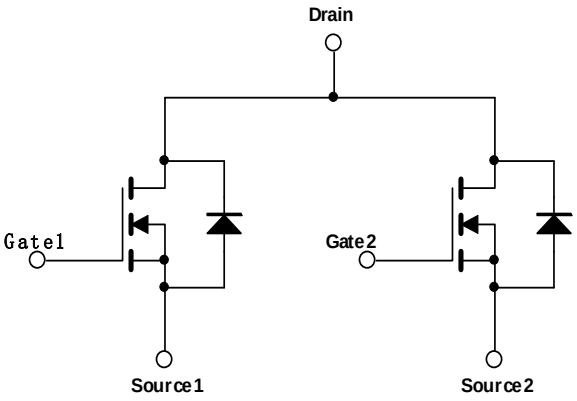
8205SS (文件编号:S&CIC1478) N 沟道功率 MOS 场效应用管



SOT23-6



绝对最大额定值（T_A=25℃，除非另有说明。）

参数	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	20	V
栅源电压	V_{GS}	±8	V
漏极电流	I_D	5	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	16	A
存储温度	TS_{TG}	-55 to +150	℃
工作结温	T_J	-55 to +150	℃

电特性（T_A=25℃，除非另有说明。）

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
特性（OFF）						
漏源击穿电压	BV_{DSS}	V_{GS}=0V, I_{DS}=250uA	20	--	--	V
栅源短路时漏极电流	I_{DSS}	V_{DS}=16V, V_{GS}=0V	--	--	1	uA
漏极短路时截止栅电流	I_{GSS}	V_{GS}=±8V, V_{DS}=0V	--	--	±100	nA
特性（ON）						
栅极阈值电压	$V_{GS(TH)}$	V_{DS}=V_{GS}, I_{DS}=250uA	0.45	0.65	1.0	V
漏源电阻	$R_{DS(ON)}$	V_{GS}=4.5V, I_D=3A	--	24	30	mΩ
		V_{GS}=2.5V, I_D=2A	--	28	35	
漏源二极管特性及最大额定值						
漏源二极管正向电压	V_{SD}	V_{GS}=0V, I_{DS}=4.5A	--	--	1.3	V
栅极输入电阻	R_G	V_{GS}=0.V_{DS}=0.V Frequency=1MHZ	--	2.5	--	Ω